## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Никишов А. И., Ритус В. И. Тр. ФИАН, 1979, т. 111. [2] Жуковский В. Ч., Херрмани И. Ядерная физика, 1971, 14, с. 150. [3] Берестецкий В. Б., Лифшиц Е. М., Питаевский Л. П. Квантовая электродинамика. М.: Наука, 1980. [4] Волков Д. М. ЖЭТФ, 1937, 7, с. 1286. [5] Соколов А. А., Тернов И. М. Релятивистский электрон. М.: Наука, 1974. [6] Соколов А. А., Борисов А. В., Жуковский В. Ч. Изв. вузов. Физика, 1975, 10, с. 51.

Поступила в редакцию 07.09.83

#### ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 3. ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ, 1984, т. 25, № 3

## УДК 539.23

# СТРУКТУРА И СОСТАВ ПЛЕНОК Gd—Fe, ПОЛУЧЕННЫХ В РАЗРЯДЕ С ОСЦИЛЛИРУЮЩИМИ ЭЛЕКТРОНАМИ

### Г. В. Смирницкая, Э. М. Рейхрудель, Н. Н. Кононкова

(кафедра общей физики для естественных факультетов)

В последние годы аморфные пленки редкоземельных-переходных металлов привлекли внимание ученых в связи с использованием их в термомагнитных записывающих устройствах. В работе [1] аморфные пленки Gd--Co, Gd--Co--Мо толщиной 80-600 Å получались распылением в высокочастотном разряде на подложках из NaCl. Пленки имели периодическую структуру, состоящую из стержней и тонких пластинок; содержание кислорода в пленках равнялось 0.15 - 0.20. В работе [2] установлено, что столбчатая структура пленок Gd—Co, Gd—Fe зависит от  $p_{Ar}$  и от напряжения смещения на пленке (V) и пропадает при увеличении p<sub>Ar</sub> и при V >> 50 В. Показано [3], что пленки Gd—Fe толщиной 0,7—12 мкм, полученные распылением в Ar. аморфные при содержании Gd больше 20 ат.% и аморфно-кристаллические при содержании Gd меньше 15 ат. %. В работе [4] установлено, что присутствие О<sub>2</sub> увеличивает перпендикулярную анизотропию пленок Gd—Co, а присутствие N2 уменьшает ее. Обнаружено [5], что взаимодействие воздуха с пленкой Gd—Fe уничтожает перпендикулярную анизотропию. Для защиты пленок от воздействия воздуха на них наносился слой Si-O. В работе [6] аморфные пленки GdFe. GdCo получались методом взрывного испарения. Температура Кюри зависела от содержания Ar и O2 в пленках. В работе [7] установлено, что пленки Gd—Fe толщиной больше 10<sup>4</sup> Å, полученные в высокочастотном разряде при остаточном давлении 5.10-7 мм рт. ст. и рАг = =10<sup>-2</sup> мм рт. ст., имели окисленный слой толщиной ~1000 Å. Большое проникновение O<sub>2</sub> в глубину указывало на пористость пленок. Наблюдалось образование кристаллической фазы окислов в виде звезд.

В настоящей работе пленки Gd—Fe получались в разряде с осциллирующими электронами. Описание метода и установки дано в работе [8]. В качестве подложек использовался ситалл и полированное стекло K8, подложки находились при потенциале анода (земля). Перед нанесением пленок подложки прогревались в вакууме при T == 300°C в течение часа. Нагрев производился тепловым излучением прямонакаливаемых Та-лент. Катоды состояли из поликристаллического сплава GdFe<sub>2</sub>. Дифрактограмма с поверхности катода обнаружила также присутствие окислов Gd и Fe. Химический состав, полученный на рентгеновском микроанализаторе XMA-5B, показал неоди-

30

наковое содержание Gd и Fe в разных участках катода. Для уменьщения содержания инертного газа в пленках и для предотвращения воздействия энергичных нейтралов на пленку [9] распыление производилось в криптоне. Катоды очищались распылением их ионной бомбардировкой при закрытых подложках и давлении  $p_{\rm Kr} \sim 10^{-5}$  мм рт. ст. в течение 30 мин. После этого вентиль на насосе НЭМ-300 перекрывался и катоды распылялись в течение 30 мин при давлении  $p_{\mathsf{Kr}} \sim$ ~10-4 мм рт. ст.; при этом работал дополнительный магниторазрядный стеклянный насос, который являлся геттером активных газов. Давление остаточных газов было ~ 5·10<sup>-8</sup> мм рт. ст. После предварительного распыления заслонки открывались и производилось нанесение пленок на подложки, помещенные за окнами в цилиндрическом аноде. Толшина пленок определялась интерферометром МИИ-5 и контролировалась также взвешиванием подложек до и после нанесения на них пленок. Структура пленок исследовалась на рентгеновском дифрактометре УРС-50 ИМ. Съемка велась на Со Ка-излучении с β-фильтром из Fe. Химический состав поверхности пленки опрелелялся на рентгеновском микроанализаторе ХМА-5В. Состав химических элементов в пленках исследовался с помощью оже-электронного анализа на установке Varian. Применялось травление пучком ускоренных ионов Ar+ с энергией 2 кэВ. Микрорельеф поверхности пленок исследовался с помощью металломикроскопа и растрового электронного микроскопа. Нанесение пленок происходило при анодном напряжении 2,5 кВ, H=275 Э и при двух значениях pkr, соответствующих различным режимам разряда: 1)  $p_{\rm Kr} = 5 \cdot 10^{-4}$  мм рт. ст., разрядный ток  $I_{\rm p} =$ =4 мА (плазменный режим разряда), 2)  $p_{Kr}=2\cdot 10^{-4}$  мм рт. ст.,  $I_p=$ =900 мкА (режим разряда с отрицательным пространственным зарядом).

Измерения показали, что скорость напыления пленок в плазменном режиме разряда равнялась  $S=22\pm 2$  Å/мин; при режиме с отрицательным пространственным зарядом  $S=20\pm 2$  Å/мин. Масса, напыляемая на единицу тока в единицу времени, в плазменном режиме равнялась  $M=0,6\cdot 10^{-3}$  г/( $A\cdot$ мин), в режиме с отрицательным пространственным зарядом  $M=1,9\cdot 10^{-3}$  г/( $A\cdot$ мин). Уменьшение M в плазменном режиме объясняется уменьшением энергии ионов, бомбардирующих катоды, и угла их падения на катод, что приводит к уменьшению коэффициента катодного распыления, а также тем, что при этих значениях давления возможны также соударения распыляемых атомов с атомами газа и обратное возвращение их на катод.

Опыты показали, что пленки, нанесенные в плазменном режиме, были аморфными независимо от рода подложки. На рис. 1 показаны дифрактограммы пленки толщиной 3,1 мкм, нанесенной на стекле в плазменном режиме. Дифрактограмма *a* снята через месяц после выноса пленки в атмосферу; видно, что пленка имеет аморфное строение. Дифрактограмма *b* снята после 12 мес пребывания пленки на воздухе (намечается появление максимумов, соответствующих образованию окислов), а *в* — через 15 мес нахождения пленки на воздухе (максимумы —  $Gd_2O_3$ ,  $Fe_2O_3$  — стали более отчетливыми). Дифрактограммы обнаруживают медленное окисление пленки и ее кристаллизацию при нахождении на воздухе. Процесс зависит от толщины пленки и для тонкой пленки протекает быстрее.

На рис. 2, а приведена дифрактограмма первоначально аморфной пленки толщиной 0,6 мкм, снятая через 12 мес пребывания пленки на воздухе. Максимумы соответствуют окислам Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> и Gd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Дифрактограммы, снятые с пленок, нанесенных в режиме разряда с отрица-

тельным пространственным зарядом, сразу после нанесения обнаруживали максимумы (рис. 2, б), которые соответствовали Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, FeO, Gd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Образование кристаллографической структуры в пленках зависит от степени подвижности адсорбированных атомов. При распыле-



Рис. 1. Дифрактограммы пленок толщиной 3,1 мкм (плазменный режим): а — через 1, б — через 12 и в — через 15 мес пребывания пленки на воздухе (d — постоянная решетки)

нии катодов ионами большой энергии при низком рабочем давлении средняя подвижность осажденных частиц значительно выше, чем при распылении в плазменном режиме; это способствует кристаллизации. Кроме того, при более низком давлении инертного газа увеличивается относительная доля примесей, что может вызвать окисление пленки в процессе образования.

Исследование химического состава пленок на рентгеновском микроанализаторе показало, что пленки однородны по составу. Измерения показали, что в пленках через несколько часов после выноса их на воздух содержание Fe (неокисленного) составляло  $62\pm 3$  ат.%, Gd (неокисленного) — 23,3 $\pm$ 0,7 ат.%, остальное — примеси O, C, осажденные из воздуха. Через 2 мес пребывания пленок в атмосфере



Рис. 2. Дифрактограммы пленок: а — толщиной 0,6 мкм (плазменный режим) через 12 мес пребывания на воздухе, б — толщиной 1,3 мкм (режим разряда низкого давления) через 1,5 мес

их состав изменился, содержание Fe стало  $58\pm3$  ат.%, Gd —  $17.7\pm \pm 0.7$  ат.%. Пленки, находящиеся на воздухе в течение года, имели содержание Fe  $49\pm2$  ат.%, Gd  $2.2\pm0.5$  ат.%. Защита пленок от окисления на воздухе может быть достигнута нанесением на них слоя SiO,  $Al_2O_3$  или Sr. Наблюдение поверхности аморфных пленок, полученных



Рис. 3. Поверхность пленки толщиной 5 мкм ( $p_{\rm Kr}=2\cdot10^{-4}$  мм рт. ст.): a — металломикроскоп, увеличение 200, подложка — стекло,  $\delta$  — электронный микроскоп, увеличение 555, подложка — ситалл. Распределение железа по поверхности пленки в области «звезды» в растровом электронном микроскопе —  $\beta$ 

в плазменном режиме, на металломикроскопе и в электронном микроскопе показало, что поверхность их однородна. В толстых пленках ( $\sim 5$  мкм), нанесенных в режиме низкого давления на стеклянную подложку, наблюдалось образование «звезд» (рис. 3, *a*), а в пленках



Рис. 4. Оже-спектры пленки толщиной 5 мкм,  $p_{\rm Kr}=2\cdot 10^{-4}$  мм рт. ст., подложка— стекло: a — с поверхности пленки,  $\delta$  — с глубины 150 Å

на ситалловых подложках возникала стержневая структура (рис. 3, 6). Исследование химического состава «звезд» показало, что он не отличается от химического состава всей пленки. На рис. 3, в показано распределение железа по поверхности пленки в области «звезды».

На рис. 4 приведены ожеспектры пленки толщиной 5 мкм на стекле, полученной в режиме разряда с отрицательным пространственным зарядом. Пики О и С, довольно значительные на поверхности пленки, сильно уменьшаются на глибине 150 Å, что говорит об адсорбции компонент из воздуха.

Проведенные исследования показывают, что структура пленок (аморфная или аморфнокристаллическая) зависит от режима разряда с осциллирующими электронами. Аморфные пленки Gd—Fe не являются устойчивыми и постепенно окисляются и кристаллизуются, поэтому для сох-

ранения их свойств необходимо покрывать пленки слоями (SiO, Sr, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), предохраняющими их от окисления.

Авторы выражают искреннюю благодарность Ф. Г. Щегловой, О. С. Щеглову, Р. П. Баберцяну за участие в экспериментах.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Graczyk J. F. J. Appl. Phys., 1978, 49, N 3, p. 1738. [2] Kusuda T., Honda S., Ohkoshi M. J. Appl. Phys., 1982, 53, N 3, p. 2338. [3] Mimura Y. et al. J. Appl. Phys., 1978, 49, N 3, p. 1208. [4] Hoshi Y., Nave M., Yamanaka S. J. Appl. Phys., 1982, 53, N 3, p. 2344. [5] Tsunashima S. et al. J. Appl. Phys., 1980, 51, N 11, p. 5901. [6] Аностолов А. н др. Болг. физ. журн., 1979, 6, № 4, с. 472. [7] Gill H., Chen M., Judy J. J. Appl. Phys., 1978, 49, N 3, p. 1741. [8] Кононкова Н. Н., Рейхрудель Э. М., Смирницкая Г. В. ЖТФ, 1980, 50, с. 599. [9] Козловский Л. В., Рейхрудель Э. М., Смирницкая Г. В. В кн.: Взаимодействие атомных частиц с твердым телом. Ч. 2. Минск, 1981, с. 253.

Поступила в редакцию 21.09.83